



深圳市大雁科技实业有限公司

Dayan Technology Industry Co., Ltd. Shenzhen



3DD13005

1. 主要特点

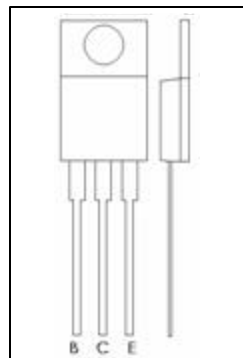
硅 NPN 三重扩散平面结构
击穿电压高
电流容量大
开关时间短
安全工作区大

2. 封装形式 TO-220

3. 主要用途

电子镇流器及各类功率开关电路

4. 绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$



项目	符号	数值	单位
集电极—基极直流电压	V_{CBO}	700	V
集电极—发射极直流电压	V_{CEO}	400	V
发射极—基极直流电压	V_{EBO}	9	V
集电极直流电流	I_C	5	A
集电极耗散功率 $T_a=25^{\circ}\text{C}$	P_C	3.0	W
$T_c=25^{\circ}\text{C}$		75	W
最高结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

5 电特性 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

项目	符号	测试条件	规范		单位
			Min	Max	
集电极—基极直流电压	BV_{CBO}	$I_C=1\text{mA}$ $I_E=0$	700		V
集电极—发射极直流电压	BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=0$	400		V
发射极—基极直流电压	BV_{EBO}	$I_E=1\text{mA}$ $I_C=0$	9		V
集电极—基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=680\text{V}$ $I_E=0$		5	μA
集电极—发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=390\text{V}$ $I_B=0$		5	μA
发射极—基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9\text{V}$ $I_C=0$		5	μA
集电极—发射极饱和压降	$V_{CE\text{sat}}$	$I_C=1\text{A}$ $I_B=0.2\text{A}$		0.5	V
		$I_C=4\text{A}$ $I_B=1\text{A}$		1.0	V
基极—发射极饱和压降	$V_{BE\text{sat}}$	$I_C=1\text{A}$ $I_B=0.2\text{A}$		1.2	V
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{A}$	15	30	5 倍分档
下降时间	t_f	$I_C=0.5\text{A}$		0.5	μs
贮存时间	t_s	$I_{B1}=-I_{B2}=0.1\text{A}$		5	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_C=500\text{mA}$ $f=1\text{MHz}$	5		MHz

地址：广东省深圳市南山区西丽留仙大道桑泰工业园 1 栋

邮编：518055 - 1 -

电话：0755-86020755 传真：0755-86020855

网址：http://www.dayan.com.cn

2005-3-11